

SOT223 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

ISSUE 3 - OCTOBER 1995

FZT796A

FEATURES

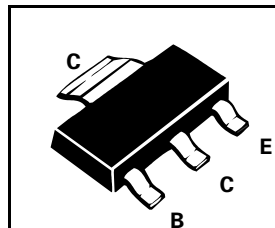
- * 200 Volt V_{CEO}
- * Gain of 250 at $I_C=0.3$ Amps
- * Very low saturation voltage

APPLICATIONS

- * Battery powered circuits

COMPLEMENTARY TYPE - FZT696B

PARTMARKING DETAIL - FZT796A



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-200	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-200	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-1	A
Continuous Collector Current	I_C	-0.5	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$)

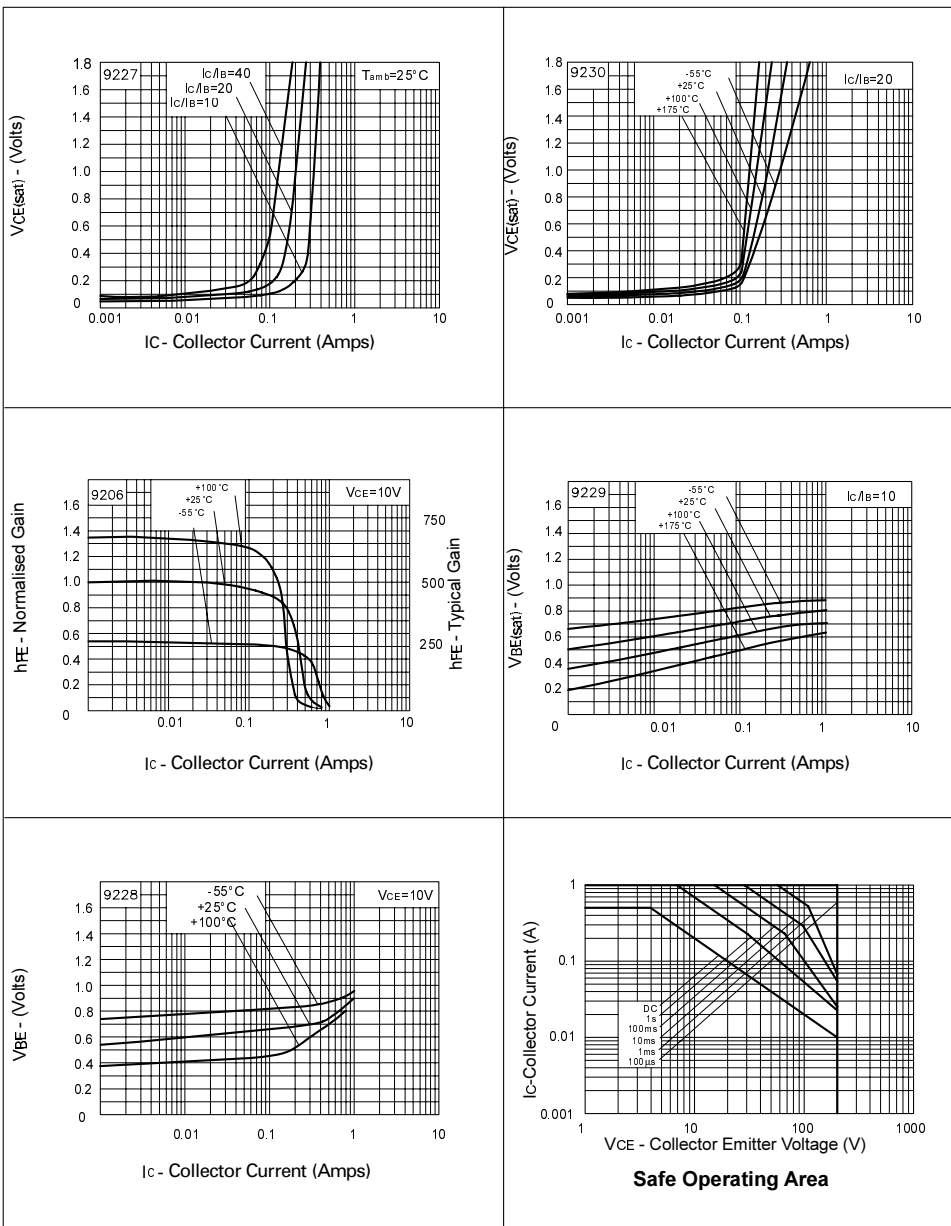
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-200			V	$I_C=-100\mu A$
Collector-Base	$V_{(BR)CEO}$	-200			V	$I_C=-10mA^*$
Collector-Emitter	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E=-100\mu A$
Emitter-Base						
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-0.1	μA	$V_{CB}=-150V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-0.1	μA	$V_{EB}=-4V$
Collector-Emitter	$V_{CE(sat)}$			-0.2 -0.3 -0.3	V V V	$I_C=-50mA, I_B=-2mA^*$ $I_C=-100mA, I_B=-5mA^*$ $I_C=200mA, I_B=-20mA^*$
Saturation Voltage						
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			-0.95	V	$I_C=200mA, I_B=20mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.67		V	$I_C=200mA, V_{CE}=-10V^*$
Static Forward Current	h_{FE}	300 300 250 100		800		$I_C=10mA, V_{CE}=-10V^*$ $I_C=100mA, V_{CE}=-10V^*$ $I_C=300mA, V_{CE}=-10V^*$ $I_C=400mA, V_{CE}=-10V^*$
Transfer Ratio						
Transition Frequency	f_T	100			MHz	$I_C=50mA, V_{CE}=-5V$ $f=50MHz$
Input Capacitance	C_{ibo}		225		pF	$V_{EB}=-0.5V, f=1MHz$
Output Capacitance	C_{obo}		12		pF	$V_{CB}=-10V, f=1MHz$
Switching Times	t_{on} t_{off}		100 3200		ns ns	$I_C=100mA, I_{B1}=-10mA$ $I_{B2}=-10mA, V_{CC}=-50V$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for this device

FZT796A

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9